ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ $(Bi_2Te_3)_{1-x}(TlA^{III}B_2^{VI})_x$

Ч.И.АБИЛОВ

Азербайджанский Технический Университет Az1073, Баку-73, пр. Г.Джавида, 25

М.М.СЕИДОВ, Я.Н.БАБАЕВ

Нахичеванский Государственный Университет Нахичеван-373630, Университетский городок

Исследованы температурные зависимости (80-750К) электрофизических параметров твердых растворов $(Bi_2Te_3)_{1-x}(TlA^{III}B_2^{VI})_x$. Определены значения термоэлектрической эффективности отдельных составов при различных температурах. Показано, что сплавы твердого раствора $(Bi_2Te_3)_{1-x}(TlA^{III}B_2^{VI})_x$ обладают относительно высоким значением термоэлектрической эффективности и их можно использовать при изготовлении преобразователей энергии.

The temperature dependences (80-750 K) of electrophysical parameters of solid solutions $(Bi_2Te_3)_{1-x}(TlA^{III}B_2^{VI})_x$ are investigated. The meaning thermoelectrically effectively of some separately compositions the different temperatures are studied. Values of thermoelectric efficiencies $(Bi_2Te_3)_{1-x}(TlA^{III}B_2^{VI})_x$ structures are certain at various temperatures. Alloys of the solid solution possess rather high vale of thermoelectric efficiency and they can be used at manufacturing alternative converters of energy.

В связи с тем, что Bi_2Te_3 является надежным термоэлектрическим материалом, выявление на его основе новых сложных по составу твердых растворов и определение пригодности применения их в создании преобразователей энергии является актуальной задачей твердотельной электроники.

Ранее нами был изучен характер физико-химического взаимодействия между Bi_2Te_3 и соединениями типа $TlA^{III}B_2^{VI}$ (где $A^{III}=GaIn; B^{VI}=Se,Te$). При построении диаграмм состояния было определено, что во всех системах существует области твердых растворов на основе Bi_2Te_3 [1-3]. Поэтому изучались температурные зависимости электрофизических параметров различных составов из этих гомогенных областей и определены значения термоэлектрической мощности $\alpha^2 \sigma$ и коэффициента эффективности (Z) ряда сплавов. Электрофизические параметры исследовались в интервале 80-750К (кроме общей теплопроводности, которая исследовалась при 300-700К) на поликристаллических образцах параллелепипедной формы по методике [4]. На температурных зависимостях термоэлектрических параметров твердых растворов $(Bi_2Te_3)_{1-x}(TlA^{III}B_2^{VI})_x$ наблюдаются некоторые аномальные поведения связанные, по-видимому, как со сложностью составов, так и с особенностями электронных конфигураций замененных и замещающих элементов. Всем сплавам присуща общая закономерность увеличения значений термической ширины запрещенной зоны с ростом в составе твердых растворов количества второго компонента. Это связано с усилением локализации электронов, статистически расположенных между атомами и пустотами- (вакансиями) в кристаллической решетке формирующихся твердых растворов. Одновременно важную роль в этом вопросе играет и разница между значениями электроотрицательностей замененных и замещающих элементов. Наряду с указанными особенностями электрофизических параметров, определенной значимостью обладают температурные зависимости термоэлектрической ($\alpha^2\sigma$) мощности и эффективности (Z) новых твердых растворов (Bi_2Te_3)_{1-x} ($TlA^{III}B_2^{VI}$)_x.

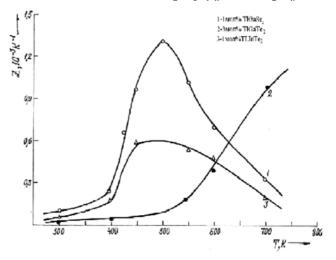


Рис.1. Температурная зависимость коэффициента термоэлектрической эффективности некоторых составов твердых растворов $(Bi_2Te_3)_{1-x}(TlA^{III}B_2^{VI})_x$

На рис.1 представлена температурная зависимость коэффициента термоэлектрической эффективности некоторых составов твердых растворов $(Bi_2Te_3)_{1-x}(TlA^{III}B_2^{VI})_x$. Видно, что термоэлектрическая эффективность исследуемых сплавов имеет средние

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ (Bi_2Te_3)_{1-x}($TIA^{III}B_2^{VI}$)_x

значения. Если учесть, что применяемые в термоэлектрических преобразователях энергии твердые растворы на основе Bi_2Te_3 при 300 К имеют значение Z в пределе $(0,6\div1,1)\cdot10^{-3}$ К [5], то полученных в настоящей работе значения термоэлектрической эффективности для твердых растворов $(Bi_2Te_3)_{1-x}(TIA^{III}B_2^{VI})_x$ можно считать приемлемыми. Несмотря на то, что твердый раствор со- $(Bi_2Te_3)_{0.99}(TlGaSe_2)_{0.01}$ имеет относительно высокое значение Z, однако интервал рабочей температуры этого сплава не широкий. Твердый раствор $(Bi_2Te_3)_{0.99}(TlInTe_2)_{0.01}$ обладает несколько низкими значениями Z, однако предел рабочей температуры у него более расширенный, что является важным фактором для техники термоэлектричества. Для других составов исследуемых твердых растворов, которые не отражены зависимостью Z~f(T) на рис. 1, рассчитаны значения $\alpha^2 \sigma$. Так, частности $(Bi_{2}Te_{3})_{0.97}(TlGaSe_{2})_{0.03}$ при $80 K\alpha^{2}\sigma = 1.8 \cdot 10^{-6}$

Вт/смК², при 300K $\alpha^2\sigma=6,0\cdot 10^{-6}$ Вт/смК², при 500K $\alpha^2\sigma=18,4\cdot 10^{-6}$ Вт/смК² и при 700K $\alpha^2\sigma=6,0\cdot 10^{-6}$ Вт/смК². Этот состав при 550K обладает значением $Z=1,1\cdot 10^{-3}$ K^{-1} . Твердый раствор состава $(Bi_2Te_3)_{0,99}(TlGaTe_2)_{0,01}$ имеет; при 300 К $\alpha^2\sigma=0,3\cdot 10^{-6}$ Вт/смК² и при 600K $\alpha^2\sigma=3,2\cdot 10^{-6}$ Вт/смК². Твердый раствор $(Bi_2Te_3)_{0,97}(TlInTe_2)_{0,03}$ при 300 К имеет $\alpha^2\sigma=0,2\cdot 10^{-6}$ Вт/смК², при 500 К $\alpha^2\sigma=0,6\cdot 10^{-6}$ Вт/смК² и при 700K $\alpha^2\sigma=1,1\cdot 10^{-6}$ Вт/смК².

Таким образом, результаты исследования термоэлектрических свойств показали, что среди твердых растворов $(Bi_2Te_3)_{1-x}(TlA^{III}B_2^{VI})_x$ имеются составы, обладающие приемлемыми значениями эффективности, и они могут использоваться при изготовлении термоэлектрических преобразователей.

Received: 10.02.2007

^{[1].} *Ч.И.Абилов, М.М.Сеидов.* Фазовая диаграмма и электрофизические свойства сплавов системы Bi_2Te_3 - $TlGaTe_2$. Изв. РАН Неорган. Материалы. 2005, т.41, №7, с.285-286.

^{[2].} М.М.Сеидов, Ч.И.Абилов, Я.Н.Бабаев. Физико-химические свойства сплавов системы Bi_2Te_3 - [5]. $TlGaSe_2$. Изв. ВУЗ России Химия и химическая технология. 2004, т.47, №4, с. 159-161.

^{[3].} *М.М.Сеидов*. Фазовая диаграмма Bi_2Te_3 - $TlGaTe_2$. Материалы XIX конференции по химии. Турция,

Измир, 2005, Типогр. Эгейского университета, с. 736.

^{[4].} Л.П.Павлов Методы измерения параметров полупроводниковых материалов. М., Высш. шк., 1987, 239с.

^{5].} *Б.М.Гольцман, В.А.Кудинов, И.А.Смирнов* Полупроводниковые термоэлектрические материалы на основе Bi_2Te_3 . М., Наука, 1973, 321 с.